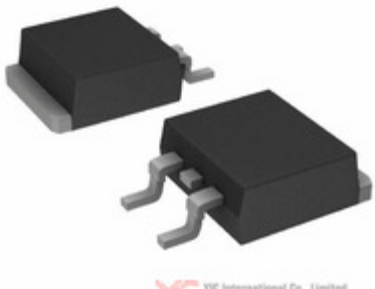

	<h2 style="color: red;">IPB042N10N3GE8187ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB042N10N3GE8187ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 100A TO263-3
Datenblätter:	 IPB042N10N3GE8187ATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB042N10N3GE8187ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 100A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 150µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8410pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	117nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPB042N10N3GE8187ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB042N10N3GE8187ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB042N10N3GE8187ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB042N10N3GE8187ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB042N10N3G INFINEO IPB042N10N3G INFINEO</p>	 <p>IPB044N15N5ATMA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p>IPB042N03LG I IPB042N03LG I</p>	 <p>IPB042N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 100A TO263-3</p>
 <p>IPB048N06LG I IPB048N06LG I</p>	 <p>IPB048N06LGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 100A TO-263</p>	 <p>IPB042N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 70A TO-263-3</p>	 <p>IPB048N15N5ATMA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB042N10N3GE8187ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB042N10N3GE8187ATMA1 Datenblatt	IPB042N10N3GE8187ATMA1- Datenblätter	IPB042N10N3GE8187ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB042N10N3GE8187ATMA1
IPB042N10N3GE8187ATMA1 Electronic	IPB042N10N3GE8187ATMA1- Komponenten	IPB042N10N3GE8187ATMA1-Verteiler	IPB042N10N3GE8187ATMA1-Bild	IPB042N10N3GE8187ATMA1-Teil
IPB042N10N3GE8187ATMA1 Aktie	IPB042N10N3GE8187ATMA1 Inventar	IPB042N10N3GE8187ATMA1 Neu	IPB042N10N3GE8187ATMA1 Hersteller	IPB042N10N3GE8187ATMA1 Bild
IPB042N10N3GE8187ATMA1 RFQ	IPB042N10N3GE8187ATMA1 Online bestellen		IPB042N10N3GE8187ATMA1 Original	IPB042N10N3GE8187ATMA1 garantiert